DEVELOPMENT ON SUPERCONDUCTING CAVITIES AT SHI

Y.Matsubara 、H.Saito 、M.Hirose H.Inoue^{*} 、M.Ono^{*} 、S.Noguchi^{*} 、K. Saito^{*} 、T.Shishido^{*}

Sumitomo Heavy Industries, ltd. (SHI) 2-1-1, YATO-CHO, TANASHI-CITY, TOKYO 188 JAPAN * High Energy accelerator research organization (KEK) 1-1, OHO, TSUKUBA-SHI, IBARAKI-KEN, 305 JAPAN

ABSTRACT

Developments on superconducting cavities have been started in 1997 under the collaboration with KEK, to learn many know-hows in this field. We fabricated a single cell L-band cavity. The KEK standard surface treatments were applied for the fabrication of the cavity .In this paper we will report the results of the measurement to this cavity and activities at Sumitomo heavy industries, ltd.

Lバンドー超電導キャビティーの開発

1. はじめに

Nbを用いた超電導加速空洞の理論的な最大加 速電界はおよそ50MV/mに達する。KEKでは すでに加速電界40MV/mの達成経緯をもち高 加速電界に対してはほぼ限界に到達しつつある。

一方で、30MV/mの加速電界であればバレル
研磨と呼ばれる機械研磨、800度の真空アニール、
電解研磨(EP:30μm以上)及び高圧水洗(HPR)
との組合せ処理により高い再現性を得ている。

現時点では予備研磨(仕上げ電解研磨前の機械研 磨及び化学研磨)のいかんに関わらず仕上げの研磨 方法は電解研磨が有効だとする意見に向かいつつ ある。

大規模な超電導LINACの実現において大量 生産性および低コスト化の問題は製作に携わるも のに興味がある。

当社も'97年度よりKEKとの共同研究に着手した。現在では 100 μm程度の予備研磨が必要とされている。約10日を要するバレル研磨を省きどこまで空洞の性能を引き出すことができるかを検討することにした。

われわれはの目標は、Nb空洞の表面研磨方法と して平均 30 μ mの電解研磨を重ねて行きながら最 適な研磨量を調べることにある。

空洞の性能測定はKEKのテストスタンド(縦測

定)にて行われた。

現時点での実験結果をまとめてみたのでここに 報告する。

2.形状
製作したNb加速空洞の形状をFig.-1に示す。



Fig. -1 単セルテスト空洞の外形と仕様

3. 空洞の製作方法

Nb加速空洞はハーフセル、ビームパイプ及びフ ランジより構成される。Nbハーフセルは深絞り成 形法により成形された後、トリミング加工される。 それぞれの部品はFig.-2に示すように電子ビ ーム溶接により一体化される。

製作に使用されたNbは東京電解(株)製であり 残留抵抗比RRRは180以上(フランジ:RRR = 80)である。



F i g-2. テスト空洞の組立



photo-1.電子ビーム溶接終了後のNb空洞

4. 表面処理

Nb空洞は化学研磨により約20µmの研磨後、 800℃-5時間の真空アニールを実施した。

アニール後、 電解研磨 (photo-3) により約 30 μ m研磨された後、高圧水洗と呼ばれる洗浄を 実施した。高圧水洗は加圧ポンプにて約80kgf / cm²まで加圧した純水を特殊なノズルを通し て空洞表面に吹き付けて洗浄する方法である。最後 に、洗浄治具取り外しの際に混入するごみを除去す る目的のため再度、空洞表面をかるく純水洗浄 (シ +7-洗浄) した。



photo-2. 電解研磨の風景

5. 実験方法

表面処理を施したNb空洞はKEKに持ち込ま れフランジの一端にインプットカプラーそして他 端にトランスミット測定端子がIn(インジウム) シールを介して取り付けられる。組立はいずれも class-10のクリーンルーム内にて実施さ れた。

インプットカプラー部に取り付けられた真空排 気ポートからターボ分子ポンプとイオンポンプに より~10⁻¹⁰torrまで排気(途中約12時間 -80℃ベーキングが施される)された後、そのま まの状態にて真空封じされ、テストスタンドに取り 付けられる。

Nb空洞は4.2Kまで冷却される(侵漬冷却)。 Nbの表面抵抗は1.5Kまで冷却すると4.2Kのと きと比べると約3桁小さくなる(表面抵抗は材質の 表面状態にも依存する)。したがって、より温度が 低いほうが空洞表面での壁損失が小さくなるので 空洞の性能としてより高いQ値が得られる。

一方で加速電界(E acc)は、表面状態、形状に 依存する Multipacting や field emission によりほ ほ決定されてしまう。いずれにせよ、より高い加速 電界を得るためには必然的に超流動状態の液体 He を使用するシステム設計が要求される。

6. 実験結果

実験結果をFig-3に示す。測定はいづれ も 1.8K である。

I. 第1回測定(総表面研磨量:50 µ m)

3 MV/m あたりからX線が発生し、徐々に 強くなったので途中で実験を中止した。

電解研磨実施前に空洞内を観察したところ
赤道部と I r i s 部の中間部に多数のピッ
ト(穴:くぼみ) が観察されていたため。実
験終了後肉眼で観察できた一番大きなピット
を CCD カメラにて内視した(photo-3)。

Π. 第2回測定(総表面研磨量:80 μm)

表面処理は 30 μ mの電解研磨と高圧水洗 及びシャワー洗浄を実施した。洗浄後、空洞 内部を観察したところ I でみられたピットは 消えていなかった。

実験結果は QUENCH により 18.3 MV/m の 加速電界が制限となった。一方で、 実験中X 線は観測されなかった。

 □. 第3回測定(総表面研磨量:110 μm) 表面処理は第2回と同様。また、ピットの 存在もそのままであった(肉眼観察のみ)。
16MV/m あたりからX線がではじめたがエー ジングをすることで22.3MV/m まで加速電界 のばすことができた。



- F i g-3. 実験により得られたQ値と加速電界 Q₀₋1:CP20 µ m+800℃anneal5Hr+EP30 µ m+HPR Q₀₋2:EP30 µ m+HPR Q₀₋3:EP30 µ m+HPR
- 7. 考察

今回の試みではピットの存在が鍵となってい たように思う。これらのピットは材料内にもと もと存在したものとみている。したがって、肉 眼で観察できるようなピットを持つ空洞性能が、 数回の少量電解研磨によりどのように変化して いくかが興味の対象となった。多数存在したう ちの1つのピット(球形と仮定する)に着目し て以下のように考える。

1.8K でのマイクロ波の侵入深さは数千(A) 程度と概算できる。われわれ着目するピットの 大きさははるかに大きい(photo-3)。このよ うな大きなピットはしばしば QUENCH の発生 要因になっている。

第一回目の研磨にてピットの口が開いたとす るFig-4(a)。この状態ではピットが深 く洗浄性が悪かったため、表面処理時の化学的 残留物やごみが溜まりやすくなっていた。その ため、低い電界にてX線量が多かったと考える。 同図(b)では、ピットの径が大きくなった ため、(a)より洗浄性が向上した。しかし、 ピットの形状が QUENCH の発生しやすい状況 となっていた。

(c)は、(a)と同径だがピットの深さが小 さく、洗浄性がよかったため(a)に比べ高い 加速電界が得られた。





Fig-4. 研磨によるピットの深さの変位

8. まとめ

量産を考慮した場合、いままで述べてきたピットや欠陥の存在は無視できないが、現在の状況では無欠陥(ピット径:~10⁻⁹ m以内)の材料を得ることは極めて難しいと考える。ましてや、電子ビーム溶接による溶接欠陥を完全に避けることもできない。したがって、これら疑いのある欠陥を除去するにはやはりバレル研磨や 化学研磨等による 100 μ m程度の予備研磨を実施する必要があることがわかった。

謝 辞

今回、Nb空洞製作にあたり多大な指導を教 授していただいたKEK工作センター井上先生 に感謝いたします。また、表面処理に関して、 協力していただいた野村鍍金(株)の皆様に感 謝いたします。

参考文献

 K.Saito et al."R&D of Superconducting Cavities at KEK" Proc. of the 4th Workshop on RF Superconductivity, 1989
高ェネルギ-物理学研究所:OHO'87,(1987)
高ェネルギ-物理学研究所:OHO'92,(1992)